极化子单激发态的反向极化研究*

高 琨 刘晓静 刘德胜 解士杰*

(山东大学物理与微电子学院;晶体材料国家重点实验室,济南 250100)(2005年1月14日收到 2005年3月7日收到修改稿)

通过对有机高分子中极化子的单激发态进行研究,发现该态在外电场下呈现反向极化特征,极化规律与双激 子态类似.在强电场下,反向极化消失,极化子单激发态解离为一个单极化子和一个双极化子态.

关键词:极化子态,激子态,反向极化 PACC:7138,7135,4210N

1.引 言

高分子聚合物具有优良的电致发光和光学非线 性特性^[1],如以聚对苯乙炔(PPV)族为发光材料合 成的有机发光器件(organic light-emitting diodes, OLED's)已实用;电化学发光电池^[2](light-emitting electrochemical cells, LEC's)及纯有机三极管^[3]也已 研制成功;最近又有关于小分子 Alq₃ 以及齐聚物 sexithieny(T_6)作自旋极化输运材料的报道^[4-6],从 而开辟了有机自旋电子学这一新领域.

反向极化是高分子聚合物中的新现象,其物理 机理是由于有机高分子内存在较强的电子-晶格相 互作用,电子的激发导致晶格弛豫,形成高能量的带 电自陷态,从而使其极化方向有可能与外加电场反 向.从能带结构来看,如果高定域能级的占据电子数 多于低定域能级的占据电子数,就有可能出现极化 反转现象^[7—10].孙鑫等人研究了聚合物的单激发和 双激发过程,指出当两个电子同时受到光激发而跃 迁到导带上时,电子-晶格相互作用造成的晶格弛豫 会形成自束缚的双激子态,具有反向极化特征.目前 对于双激子态反向极化的起因和可能的应用以及影 响双激子态反向极化的因素都已做了较深刻的物理 分析^[7—14].但是系统内两个电子同时受激跃迁的概 率总是很低的,而且双激子态极不稳定,其寿命只有 10⁻¹⁰s 左右^[78],因此这种激发方式不容易控制,有 必要寻找其他具有反向极化特性的激发态.大家知 道,高分子聚合物通过掺杂或光激发,可以形成稳定 的单极化子^[15-21],其带隙中出现两条定域能级.如 果对其进行再次激发,则低定域能级上的电子会跃 迁到高定域能级上,从而出现高定域能级电子数多 于低定域能级电子数的情况,这正是出现反向极化 的基本条件^[7-10].Chen等人提出聚合物中极化子的 单激发态可能存在反向极化,并通过对基态简并反 式聚乙炔中极化子单激发态静态极化率的数值计 算,发现它的极化率为负值^[22].但是简并系统内的 极化子容易解离成孤子和反孤子,受外场影响明显. 本文将重点在基态非简并系统内详细探讨这一问题, 特别研究极化子单激发态在外电场下的受激发行为, 给出更直观的电荷空间分布,并分析其极化规律.

2. 模型和方法

高分子导电聚合物可分为基态简并与基态非简 并的形式.如反式聚乙炔(trans-PA)是基态简并的, 而它的同分异构体——顺式聚乙炔(cis-PA),是基 态非简并的^[23],另外,像聚对苯撑(poly(pphenylene), PPP)、聚噻吩(polythiophene, PT)等也是 基态非简并的.基态简并聚合物中可产生孤子或带 单个电荷的极化子,极化子在外场下或光激发容易 解离成孤子和反孤子;基态非简并聚合物中不但可 产生带单个电荷的极化子也可产生带两个电荷的双

^{*} 国家自然科学基金(批准号 50323006,10474056,90403110)资助的课题.

[†]E-mail :xsj@sdu.edu.cn

极化子.与基态简并聚合物相比 非简并聚合物中的 极化子要稳定得多 因此 本工作选定基态非简并的 顺式聚乙炔为研究对象.

以顺式聚乙炔单链为模型,沿链方向加一个均 匀外电场 E,则由外电场引起的第 n 个格点上的附 加势能为(在此忽略了格点运动引起的势能变化)

$$H'_{n} = eEnaC^{+}_{n,s}C_{n,s}. \qquad (1)$$

因此电场作用下,聚乙炔单链系统的哈密顿量 为(忽略电子自旋指标)

$$H_{e} = -\sum_{n} [t_{0} - a(u_{n+1} - u_{n}) + (-1)^{n} t_{1}] [C_{n+1}^{+} C_{n} + C_{n}^{+} C_{n+1}]$$

+ $\frac{1}{2} K \sum_{n} (u_{n+1} - u_{n})^{n} + \sum_{n} K'(u_{n+1} - u_{n}) + \sum_{n} eEnaC_{n}^{+} C_{n}.$ (2)

上式等号右边第一项为电子的动能项;第二项 为体系弹性能;第三项是为了防止开链的塌缩而加 入的有效场作用^[24]. t_0 表示无电子晶格作用时最近 邻电子的跃迁; t_1 为简并破缺项,体现了顺式聚乙 炔的非简并基态结构^[25]; α 为电子-晶格耦合参数; u_n 为聚乙炔链第 n 个原子基团离开没二聚化时平 衡位置的位移; $C_n^+(C_n)$ 为第 n 个位置上的电子产 生(湮没)算符;K 为原子基团间弹性力常数;a 是二 聚化前的晶格常数.

用量子力学的微扰论把体系的总能量在平衡位 置{*u⁰_n*)附近展开 ,令一阶项的系数为零 ,得到格点 平衡条件为

 $u_{n}^{0} - u_{n+1}^{0} = \frac{2\alpha}{K} \sum_{\mu}^{\infty} Z_{n,\mu}^{0} Z_{n+1,\mu}^{0} + K'/K, \quad (3)$ $\downarrow \Pr \sum_{\mu}^{\infty} \overline{k}_{n,\mu} \overline{k}_{n,\mu} = -[t_{n} - \alpha(u_{n}^{0} - u_{n-1}^{0}) + (-1)^{n-1} t_{1}] Z_{n-1,\mu}^{0} \\ \varepsilon_{\mu}^{0} Z_{n,\mu}^{0} = -[t_{0} - \alpha(u_{n+1}^{0} - u_{n}^{0}) + (-1)^{n-1} t_{1}] Z_{n-1,\mu}^{0} \\ -[t_{0} - \alpha(u_{n+1}^{0} - u_{n}^{0}) + (-1)^{n} t_{1}] Z_{n+1,\mu}^{0} \\ + e E na Z_{n,\mu}^{0}, \quad (4)$

格点净电荷密度分布为

$$\rho_n = \sum_{\mu}^{\infty} |Z_{n\,\mu}^0|^2 - 1.$$
 (5)

迭代求解方程 3 和 4 河得体系在最低能态时的晶 格位形分布、电子能级及其波函数、电荷密度分布和 体系总能量.

3. 结果和讨论

对于顺式聚乙炔,选取参数 a = 0.122nm, $t_0 = 2.5$ eV,K = 2100eV/nm²,K' = -51.263eV/nm, $t_1 = 0.03$ eV.当电子或空穴掺杂到聚乙炔链上后,电子-

晶格相互作用会导致极化子或双极化子等自陷态: 同时电子态也会发生变化 :原价带顶能级和原导带 底能级从连续能带分离进入禁带 形成带隙内的定 域能级 ε_α和 ε_α,如图 1(a).电子掺杂情况下 ,ε_α有 两个电子占据,而ε,为单电子占据.光激发将有可 能产生这样的电子跃迁 :ε_α上的电子获得能量跃迁 至 ε.,形成高能激发态,我们称之为极化子的单激 发态 计算发现 该单激发态在带隙内也只存在两条 分离能级,这两条分离能级的定域性更强,如图1 (b).晶格系统则出现更强的局域缺陷,晶格位形如 图 1(c)所示,电荷密度分布也发生了相应的变化, 如图 1(d)发现极化子单激发态电荷密度分布出现 了两个等高的峰,如果不存在禁闭项(即基态简并情 $况_{t_1} = 0$),计算发现电荷密度分布曲线的两峰会分 开,如图2所示,从其晶格位形上看,它们就像一对 孤子-反孤子,但每个"孤子"只约束 $\frac{1}{2}e$ 的净电荷, 因此 ,两个" 孤子 "之间存在量子力学约束 ,并不是真 正的分开.

为防止带电极化子在外场下定向运动,我们对 系统施加一弱电场,以检查极化子单激发态的电荷 密度行为.图 3 给出了 $t_1 = 0$,外电场分别为 0 $.5 \times 10^3$ V/cm 和 1 × 10⁴ V/cm 时极化子单激发态的电荷转 移量 $\Delta \rho_n = \rho_n (E) - \rho_n (0)$.发现在外场作用下,极化 子单激发态出现明显的反向极化特征.

反向极化强度与简并破缺参数 t₁ 有关 ,图 4 给 出了极化子单激发态电荷转移量随 t₁ 的变化曲线. 很明显 ,电荷转移量随简并破缺参数的增大而减小. 这是因为对于基态非简并系统 ,定域能级波函数的 两个峰相互重叠(如图 5 所示),简并破缺参数 t₁ 越 大 ,重叠(或禁闭),越强 因此电荷转移量越小即反向 极化强度越小 ,详细分析可参考双激子态的反向极



图 1 (a) 极化子的能级分布示意图 (b) 极化子单激发态的能级分布示意图 (c) 极化子(虚线) 及其单激发态(实线) 的晶格 位形 (d) 极化子(虚线) 及其单激发态(实线) 的电荷密度分布



图 2 *t*₁ = 0 时极化子单激发态的晶格位形(虚线)和电荷密度 分布(实线)

极化子单激发态是一种亚稳态,当电场达到某 一临界值时,这种反向极化将会被破坏,形成正向极 化.计算发现,这种正向极化实际上是相互解离的一 个正电单极化子和一个负电双极化子.图 6 给出了



图 3 $t_1 = 0$ 外电场分别为 0 5×10^3 V/cm 和 1×10^4 V/cm 时极化 子单激发态的电荷转移 $\Delta \rho_n$

解离后的电荷密度分布和晶格位形,单极化子和双 极化子在外电场的作用下相互远离,各自运动到链 端.在本文的参数选取下,得到极化子单激发态的解 离电场为3.62×10⁵V/cm,此时解离为一正电单极化







图 4 电场为 5 × 10⁴ V/cm 时 电荷转移量随简并破缺参数的变化





图 6 极化子单激发态解离后的电荷密度分布(实线)和晶格位 形(虚线),电场为 3.62×10⁵ V/cm

4.结 论

双激子态具有反向极化的特性,但是这种状态 极不稳定,而且系统内两个电子同时受激跃迁的概 率总是很低的,因此本文试图寻找其他具有反向极 化特性的激发态.基于此,对极化子单激发态进行了 理论研究,发现极化子单激发态在外电场下具有反 向极化特征.由于只需单电子激发,这种反向极化应 比双激子态的反向极化更容易实现.极化子单激发 态在较强的电场下将会解离,形成一个单极化子和 一个双极化子.需要指出的是,由于极化子在外电场 下会运动,本文只是通过弱场下的计算揭示了极化 子反向极化的特征,对其激发态的详细研究应在动 力学状态下进行.

感谢复旦大学孙鑫教授和陈良善博士生对本工作的 指导.

- Burroughes J H , Bradley D D C , Brown A R et al 1990 Nature 347 539
- [2] Pei Q , Yu G , Zhang C et al 1995 Science 269 1086
- [3] Garnier F , Horowitz G , Peng X et al 1990 Adv. Mater. 2 592
- [4] Dediu V, Murgia M, Matacotta. F C, Taliani C and Barbanera S 2002 Solid State Commun 122 181
- [5] Xiong Z H , Wu Di , Vardeny Z V and Jing S 2004 Nature 427 821
- [6] Fu J Y, Ren J F, Liu D S and Xie S J 2004 Acta Phys. Sin. 53 1989(in Chinese)[付吉永、任俊峰、刘德胜、解士杰 2004 物理 学报 53 1989]
- [7] Sun X , Fu R L , Yonemitsu K et al 2000 Phys. Rev. Lett. 84 2830

- [8] Sun X , Fu R L , Yonemitsu K and Nasu K 2001 Phys. Rev. A 64 032504
- [9] Fu R L and Sun X 2000 Progress in Physics 20 243
- [10] FuRL, YeHJ, LiL *et al* 1998 Acta Phys. Sin. **47** 94(in Chinese] 傅柔励、叶红娟、李 蕾等 1998 物理学报 **47** 94]
- [11] Chen K, Zhao E H, Sun X and Fu R L 2000 Acta Phys. Sin. 49 1778(in Chinese)]陈 科、赵二海、孙 鑫、傅柔励 2000 物理 学报 49 1778]
- [12] Wang L X , Liu D S , Wei J H et al 2002 Journal of Chemical Physics .116 6760
- [13] Wang L X, Liu D S and Xie S J 2002 Acta Phys. Sin. 51 362 in Chinese J 王鹿霞、刘德胜、解土杰 2002 物理学报 51 362]
- [14] Gao K, Fu J Y, Liu D S and Xie S J 2005 Acta Phys. Sin. 54 183
 (in Chinese] 高琨、付吉永、刘德胜、解士杰 2005 物理学报 54 183]
- [15] Heeger A J, Kivelson S, Schrieffer J R et al 1988 Rev. Mod.

Phys. 60 781

- [16] Geraldo M S 2000 Phys. Rev. B 61 10777
- [17] Rakhmanova S V and Conwell E M 2000 Synthetic Metals 110 37
- [18] An Z , Wu C Q and Sun X 2004 Phys. Rev. Lett. 93 216407
- [19] Rakhmanova S V and Conwell E M 1999 Appl. Phys. Lett. 75 1518
- [20] Johansson A and Stafstrom S 2001 Phys. Rev. Lett. 86 3602
- [21] Wang L X, Zhang D C, Liu D S, Han S H and Xie S J 2003 Acta Phys. Sin. 52 254 (in Chinese] 王鹿霞、张大成、刘德胜、韩圣 浩、解士杰 2003 物理学报 52 2547]
- [22] Chen L S ,Li S and Sun X 2003 Synthetic Metals 135-136 507
- [23] Heeger A J, Kivelson S, Schrieffer J R and Su W P 1988 Rev. Mod. Phys. 60 781
- [24] Stafstrom S and Chao K A 1984 Phys. Rev. B 29 7010
- [25] Shimo Y and Abe S 1994 Phys. Rev. B 49 14113

Inversed polarization of the single excited state of polaron *

Gao Kun Liu Xiao-Jing Liu De-Sheng Xie Shi-Jie[†]

(School of Physics and Microelectronics , Shandong University , Jinan 250100 , China ;

State Key Laboratory of Crystal Materials , Shandong University , Jinan 250100 , China)

(Received 14 January 2005; revised manuscript received 7 March 2005)

Abstract

The single excited state of a polaron in polymers has been studied. It was found that its polarization is negative under an external electric field. The single excited state of a polaron has a similar behavior with that of a biexciton. The inversed polarization will disappear under a strong electric field and the single excited state of a polaron will dissociate into a polaron and a bipolaron.

Keywords: polaron state , exciton state , inversed polarization **PACC**: 7138, 7135, 4210N

 $^{^{\}ast}$ Project supported by the National Science Foundation (Grant Nos. 50323006 ,10474056 ,90403110).

 $^{^{\}dagger}\text{E-mail:xsj@sdu.edu.cn}$